

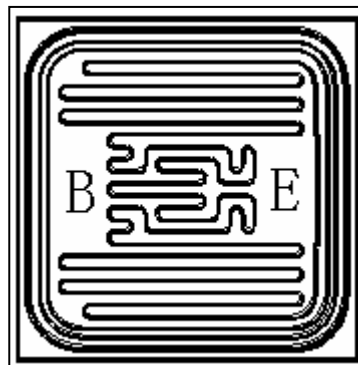


13005 晶体管芯片说明书

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸 (100mm)
 芯片代码：D283AG-00
 芯片厚度：240±20μm
 管芯尺寸：2830×2830μm²
 焊位尺寸：B 极 1200×420μm² , E 极 1140×540μm²
 电极金属：铝
 背面金属：银
 典型封装：KSE13005 , HE13005

管芯示意图



极限值 (T_a=25) (封装形式：TO-220)

T _{stg} ——贮存温度.....	-55~150
T _j ——结温.....	150
P _C ——集电极功率耗散 (T _c =25)	75W
V _{CB0} ——集电极—基极电压.....	700V
V _{CEO} ——集电极—发射极电压.....	400V
V _{EBO} ——发射极—基极电压.....	9V
I _C ——集电极电流 (DC)	4A
I _C ——集电极电流 (脉冲)	8A
I _B ——基极电流.....	2A

电参数 (T_a=25) (封装形式：TO-220)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
BV _{CEO(sus)}	集电极—发射极维持电压	400			V	I _C =10mA , I _B =0
I _{EBO}	发射极—基极截止电流			1	mA	V _{EB} =9V , I _C =0
h _{FE}	直流电流增益	10		40		V _{CE} =5V , I _C =1A
		8		40		V _{CE} =5V , I _C =2A
V _{CE(sat)}	集电极—发射极饱和电压*			0.5	V	I _C =1A , I _B =0.2A
				0.6	v	I _C =2A , I _B =0.5A
				1	V	I _C =4A , I _B =1A
V _{BE(sat)}	基极—发射极饱和电压*			1.2	V	I _C =1A , I _B =0.2A
				1.6	V	I _C =2A , I _B =0.5A
C _{ob}	共基极输出电容		65		pF	V _{CB} =10V , f=0.1MHz
f _T	特征频率	4			MHz	V _{CE} =10V , I _C =0.5A
t _{ON}	导通时间			0.8	μs	V _{CC} =125V , I _C =2A, I _{B1} =-I _{B2} =0.4A
t _{STG}	载流子贮存时间			4	μs	
t _F	下降时间			0.9	μs	